

**МОДЕЛЬ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ АНАЛИЗА КРУГЛОЙ МИКРОПОЛОСКОВОЙ АНТЕННЫ**

*Рассмотрена модель радиальной линии передачи, позволяющая определить область возможного положения зонда для эффективного возбуждения круглой микрополосковой антенны.*

**E-mail: fadееva.n.u@gmail.com**

**Ключевые слова:** радиальная линия передачи, критическое сечение, собственные волны, диаграмма направленности, эквивалентная плотность тока.

Среди многочисленных методов анализа микрополосковых антенн наиболее распространены: метод линии передачи, метод объемного резонатора, метод тензорной функции Грина [1—5]. Модель линии передачи — самая простая из всех моделей, она дает хорошее физическое понимание принципов работы микрополосковой антенны. При анализе ее излучения непосредственно используют такие характеристики линии передачи, как постоянная распространения  $\Gamma$ , характеристическое сопротивление  $Z_c$ , фазовая скорость  $v_{\text{ф}}$ , длина волны в системе  $\lambda_c$ .

**Собственные волны и собственные критические сечения радиальной линии передачи.** Радиальной линией передачи принято называть волновод, образованный двумя параллельными металлическими плоскостями, между которыми размещен однородный диэлектрик. Электромагнитные волны в таком волноводе распространяются в радиальном направлении. Поперечное сечение радиального волновода с увеличением радиальной координаты не остается постоянным, поэтому такой волновод относят к категории неоднородных волноводов.

Решение уравнений Максвелла представляется в виде суперпозиции электрических  $E_{mn}$  и магнитных  $H_{mn}$  волн, а также  $T$  волны. Как вычки означают, что данное разбиение на типы волн не соответствует принятой волноводной классификации. В этом случае направляемые волны являются цилиндрическими и распространяются вдоль радиальной координаты  $\rho$  (рис. 1) [6]. Используется цилиндрическая система координат  $\rho, \varphi, z$ .

Основной низший тип волны  $T$ , возбуждаемый в распределительных системах СВЧ на основе радиального волновода фазированных антенных решеток, исследован в работе [1]. В круглых микрополосковых антеннах этот тип волны не используется [2, 5]. Компоненты электромагнитного поля « $E_{mn}$ » и « $H_{mn}$ » типов волн выражают через скалярные функции  $U$  и  $V$  [6—9]:

$$\begin{cases} U \\ V \end{cases} = \begin{cases} A_{mn} Z_m(\gamma\rho) \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \cos\left(g_n z + \frac{n\pi}{2}\right), \\ B_{mn} \cos\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \sin\left(g_n z + \frac{n\pi}{2}\right), \end{cases} \quad (1)$$

где  $A_{mn}, B_{mn}$  — постоянные коэффициенты;  $\gamma$  — поперечное волновое число,  $\gamma^2 = k^2 - g_n^2$ ;  $k$  — волновое число в среде с параметрами  $\varepsilon_a, \mu_a$

(абсолютные значения диэлектрической и магнитной проницаемости среды между пластинами, соответственно),  $k = \omega\sqrt{\varepsilon_a\mu_a}$ ;  $m, g_n$  — собственные значения, определяемые из условия периодичности по координате  $\varphi$  и граничных условий на внутренних поверхностях пластин волновода:  $m$  — целые числа, включая 0 для волн магнитного типа и  $m \neq 0$  для волн электрического типа,  $g_n = n\pi/h$  — собственные значения радиального волновода высотой  $h$ ;  $n$  — целые числа, включая 0 для волн электрического типа и  $n \neq 0$  для волн магнитного типа.

Функции  $Z_m(\gamma\rho)$  удовлетворяют цилиндрическому уравнению Бесселя. Для того чтобы удовлетворить условию ограниченности поля при  $\gamma\rho \rightarrow 0$ , радиальную зависимость  $Z_m(\gamma\rho)$  необходимо представить в виде функции Бесселя 1-го рода  $m$ -го порядка  $J_m(\gamma\rho)$ , а чтобы удовлетворить условию излучения при  $\gamma\rho \rightarrow \infty$  необходимо  $Z_m(\gamma\rho)$  представить в виде функции Ханкеля 2-го рода  $m$ -го порядка  $H_m^{(2)}(\gamma\rho)$  (временная зависимость  $\exp(i\omega t)$ , рассматриваются прямые волны). В переходной области необходимо дополнительное исследование.

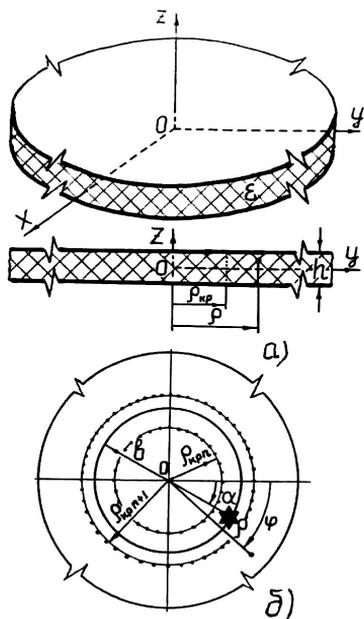
**Рис. 1. Структура радиальной линии передачи:**

*a* — линия с диэлектрическим заполнением; *б* — положение критических сечений; \* — сторонний источник электромагнитного поля

Если представить  $Z_m(\gamma\rho) = R_m(\gamma\rho) / \sqrt{\gamma\rho}$ , то от уравнения Бесселя для  $Z_m(\gamma\rho)$  для функции  $R_m(\gamma\rho)$  можно перейти к уравнению вида

$$\frac{d^2 R_m(\gamma\rho)}{d(\gamma\rho)^2} + \left[ 1 - \frac{m^2 - 0,25}{(\gamma\rho)^2} \right] R_m(\gamma\rho) = 0. \quad (2)$$

В точке поворота  $\gamma\rho = (\gamma\rho)_{\text{кр}} = \sqrt{m^2 - 0,25}$  этого дифференциального уравнения меняется характер решения так, что при  $\gamma\rho < (\gamma\rho)_{\text{кр}}$



решение данного уравнения описывает процесс затухания волны, а при  $\gamma\rho > (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  — процесс распространения волны, т. е.  $\gamma\rho = (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  является критическим сечением соответствующего типа волн, рассматриваемого неоднородного волновода [8].

Таким образом, радиальную зависимость поля  $Z_m(\gamma\rho)$  в (1), удовлетворяющую условию ограниченности при  $\gamma\rho \rightarrow 0$  условию излучения при  $\gamma\rho \rightarrow \infty$  и условию непрерывности при  $\gamma\rho = (\gamma\rho)_{\text{кр}}$ , следует записать в следующем виде:

$$Z_m(\gamma\rho) = \begin{cases} H_m^{(2)}[(\gamma\rho)_{\text{кр}}]J_m(\gamma\rho), & \gamma\rho \leq (\gamma\rho)_{\text{кр}}, \\ J_m[(\gamma\rho)_{\text{кр}}]H_m^{(2)}(\gamma\rho), & \gamma\rho \geq (\gamma\rho)_{\text{кр}}. \end{cases} \quad (2)$$

Поперечные (относительно направления распространения волн  $\rho^0$  — орта по координате  $\rho$ ) составляющие электромагнитного поля  $\mathbf{E}_\perp$ ,  $\mathbf{H}_\perp$  внутри радиального волновода представляют собой суперпозицию поперечных составляющих электромагнитного поля « $E_{mn}$ » и « $H_{mn}$ » типов волн:

$$\mathbf{E}_\perp = \sum_\nu \mathbf{E}_\perp^\nu + \sum_\mu \mathbf{E}_\perp^\mu, \quad \mathbf{H}_\perp = \sum_\nu \mathbf{H}_\perp^\nu + \sum_\mu \mathbf{H}_\perp^\mu,$$

где индекс  $\nu$  означает пару индексов  $mn$  для « $E_{mn}$ » типов волн, а индекс  $\mu$  — пару индексов  $mn$  для « $H_{mn}$ » типов волн, причем [3, 7]

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E}_\perp^\nu &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}^0 + \left( \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + k^2 U \right) \mathbf{z}^0 \\ \mathbf{H}_\perp^\nu &= -i\omega \varepsilon_a \frac{\partial U}{\partial \rho} \boldsymbol{\varphi}^0 \\ E_\rho^\nu &= \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial \rho}, \quad H_\rho^\nu = \frac{i\omega \varepsilon_a}{\rho} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \end{aligned} \right\}; \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{E}_\perp^\mu &= i\omega \mu_a \frac{\partial V}{\partial \rho} \boldsymbol{\varphi}^0 \\ \mathbf{H}_\perp^\mu &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial \varphi} \boldsymbol{\varphi}^0 + \left( \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} + k^2 V \right) \mathbf{z}^0 \\ E_\rho^\mu &= -\frac{i\omega \mu_a}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \rho}, \quad H_\rho^\mu = \frac{\partial^2 V}{\partial z \partial \rho}. \end{aligned} \right\}; \quad (4)$$

где  $\boldsymbol{\varphi}^0$ ,  $\mathbf{z}^0$  — орты по координате  $\varphi$ ,  $z$ .

«Постоянная» распространения собственных волн  $\Gamma$  определяется логарифмической производной радиальной зависимости  $\Gamma = -\gamma Z_m'(\gamma\rho) / Z_m(\gamma\rho)$ , где «'» означает производную по всему аргументу. С учетом радиальной зависимости (2) очевидно, что при  $\gamma\rho < (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  величина  $\Gamma$  действительная и представляет собой коэффициент затухания соответствующего типа волны. При  $\gamma\rho > (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  величина  $\Gamma$  комплексная, причем действительная ее часть  $\text{Re}\Gamma$  — коэффициент затухания, а мнимая  $\text{Im}\Gamma$  — фазовая «постоянная». Поскольку величина  $\Gamma$  зависит от  $\rho$ , то слово «постоянная» взято в кавычки. Основные волновые параметры каждого собственного типа волны: фазовая скорость, длина волны в системе, волновые импедансы определяются соотношениями

$$v_{\text{ф}} = \omega / \text{Im}\Gamma, \quad \lambda_c = 2\pi / \text{Im}\Gamma, \quad Z_{mn}^v = iZ_0\gamma^2 / (k\Gamma), \quad Z_{mn}^\mu = -iZ_0(k\Gamma) / \gamma^2,$$

где  $Z_0 = \sqrt{\mu_a / \varepsilon_a}$  — волновое сопротивление свободного пространства, заполненного средой с параметрами  $\varepsilon_a, \mu_a$ .

Каждый собственный тип волны в области  $\gamma\rho < (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  находится в квазистатическом состоянии, которое характеризуется реактивной мощностью, определяемой запасенной энергией. В области  $\gamma\rho > (\gamma\rho)_{\text{кр}}$  формируется излучение, характеризуемое излучаемой мощностью [7, 8]

$$P_{\Sigma}^{mn} = \frac{k\gamma^2}{\pi} \left\{ \begin{array}{l} |A_{mn}|^2 Y_0 N_v^2 \\ |B_{mn}|^2 Z_0 N_\mu^2 \end{array} \right\} J_m^2[(\gamma\rho)_{\text{кр}}],$$

где  $N_v^2, N_\mu^2$  — квадраты норм систем тригонометрических функций,  $Y_0 = 1 / Z_0$  — волновая проводимость свободного пространства.

Сопротивление излучения  $R_{\Sigma}^v$  для каждого « $E_{mn}$ » типа волны и проводимость излучения  $G_{\Sigma}^\mu$  для каждого « $H_{mn}$ » типа волны рассчитывают по следующим формулам [7, 8]:

$$\left. \begin{array}{l} R_{\Sigma}^v \\ G_{\Sigma}^\mu \end{array} \right\} = \frac{\pi\gamma}{2k} \left\{ \begin{array}{l} Z_0 \\ Y_0 \end{array} \right\} (\gamma\rho)_{\text{кр}} J_m^2[(\gamma\rho)_{\text{кр}}].$$

**Возбуждение радиального волновода при малых значениях высоты подложки микрополосковой структуры  $h$ .** Для очень тонких подложек ( $h \ll \lambda$ ) структура поля в радиальном волноводе значительно упрощается, поскольку вариации поля по оси  $z$  отсутствуют  $\partial / \partial z = 0, n = 0$  и из уравнений (3) и (4) видно, что остается только система собственных волн  $E_{m0}$ , для которой  $g_n = 0, \gamma = k$ , а компоненты поля определяются следующими выражениями:

$$E_z = k^2 U = k^2 A_{m0} Z_{m0}(k\rho) \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right);$$

$$H_\rho = \frac{i\omega\varepsilon_a}{\rho} \frac{\partial U}{\partial \varphi} = \frac{i\omega\varepsilon_a m}{\rho} A_{m0} Z_{m0}(k\rho) \cos\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right); \quad (5)$$

$$H_\varphi = -i\omega\varepsilon_a \frac{\partial U}{\partial \rho} = -i\omega\varepsilon_a k A_{m0} Z'_{m0}(k\rho) \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right).$$

Составляющие поперечного поля  $\mathbf{E}_\perp$ ,  $\mathbf{H}_\perp$  можно представить в виде разложения в ряд по полной и ортогональной системе собственных волн радиального волновода:

$$\mathbf{E}_\perp = k^2 \sum_m A_{m0} Z_m(k\rho) \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \mathbf{z}^0; \quad (6)$$

$$\mathbf{H}_\perp = -\frac{i}{Z_0} k^2 \sum_m A_{m0} Z'_m(k\rho) \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \boldsymbol{\varphi}^0. \quad (7)$$

Если сторонний источник электромагнитного поля расположен на цилиндрической поверхности  $\rho = b$  (рис. 1, б), то при  $kb > (k\rho)_{\text{кр}} = \sqrt{m^2 - 0,25}$ ,  $m = 1, 2, \dots$  и радиальную зависимость можно записать в следующем виде:

$$Z_m(k\rho) =$$

$$= J_m(kb) \begin{cases} H_m^{(2)}(k\rho), & \infty > k\rho \geq kb; \\ [1 - (1+i)\xi_m(kb)] J_m(k\rho) + N_m(k\rho), & kb \geq k\rho \geq (k\rho)_{\text{кр}}; \\ [1 + \xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}] - (1+i)\xi_m(kb)] J_m(k\rho), & (k\rho)_{\text{кр}} \geq k\rho > 0, \end{cases} \quad (8)$$

где  $\xi_m(x) = N_m(x) / J_m(x)$ .

Если сторонний источник расположен на цилиндрической поверхности  $\rho = b$ , причем  $kb < (k\rho)_{\text{кр}}$ , то радиальную зависимость можно представить в виде

$$Z_m(k\rho) =$$

$$= J_m(kb) \begin{cases} [1 - i\xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}]]^{-1} H_m^{(2)}(k\rho), & \infty > k\rho \geq k\rho; \\ [1 - \xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}]] J_m(k\rho) + N_m(k\rho), & (k\rho)_{\text{кр}} \geq k\rho > kb; \\ [1 - \xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}] + \xi_m(kb)] J_m(k\rho), & kb \geq k\rho > 0. \end{cases} \quad (9)$$

Выражения (8) и (9) записаны в таком виде, чтобы  $Z_m(k\rho)$  удовлетворяло условиям излучения при  $k\rho \rightarrow \infty$ , непрерывности при  $k\rho = kb$ ,  $k\rho = (k\rho)_{\text{кр}}$  и ограниченности при  $k\rho \rightarrow 0$ . Кроме того, они учитывают поведение поля при переходе через собственное критическое сечение [4, 7]: волновой характер поле собственной волны имеет только после критического сечения, а до критического сечения оно квазистатично.

Сторонний электрический ток с заданной плотностью  $\mathbf{I}_{\text{ст}}^3$  на цилиндрической поверхности  $\rho = b$  представим через сигнатуру поперечного вектора напряженности магнитного поля  $\mathbf{H}_{\perp}(kb)$ . Тогда используя формулы (7)—(9) и значения вронскиана цилиндрических функций Бесселя при  $k\rho = kb$ , получим

$$\mathbf{I}_{\text{ст}}^3 = [\boldsymbol{\rho}^0, \text{sign}\mathbf{H}_{\perp}(kb)] = \sum_m -\frac{2k^2 A_{m0}}{\pi kb Z_0} \begin{Bmatrix} (1-i) \\ i \end{Bmatrix} \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \mathbf{z}^0. \quad (10)$$

Верхняя строка в фигурных скобках в (10) используется для тех типов волн, для которых  $kb > (k\rho)_{\text{кр}}$ , а нижняя — для которых  $kb < (k\rho)_{\text{кр}}$ .

Выражение (10) представляет собой разложение стороннего электрического тока, заданного на поверхности  $\rho = b$  в ряд Фурье по тригонометрическим функциям на интервале  $[-\pi, \pi]$ . Обращая это выражение получим коэффициенты разложения:

$$A_{m0} = \frac{kb Z_0}{2k^2} \begin{Bmatrix} 0,5(1+i) \\ -i \end{Bmatrix} \int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{I}_{\text{ст}}^3 \sin\left(m\varphi + \frac{m\pi}{2}\right) \mathbf{z}^0 d\varphi, \quad (11)$$

а значит и решение задачи возбуждения рассматриваемого радиального волновода.

**Область возможного размещения зонда при эффективном возбуждении радиального волновода.** Пусть на цилиндрической поверхности  $\rho = b$  параллельно оси  $z$  задан линейный электрический ток. Будем считать, что амплитуда и фаза тока постоянны. Используя  $\delta$ -функцию аналитически представим ток с помощью выражения

$$\mathbf{I}_{\text{ст}}^3 = I_0^3 b^{-1} \delta(\varphi - \alpha) \mathbf{z}^0, \quad (12)$$

которое означает, что электрический ток задан в виде «бесконечно тонкой нити», расположенной в точке с координатами  $\rho = b$ ,  $\varphi = \alpha$ . Подставляя (12) в (11) и затем после интегрирования (11) в (6) и (7) получаем

$$\mathbf{E}_{\perp} = \frac{kZ_0 I_0^3}{2} \sum_m \Phi_m(\varphi, \alpha) \begin{Bmatrix} 0,5(1+i)Z_m(k\rho) \\ -iZ_m(k\rho) \end{Bmatrix} \mathbf{z}^0; \quad (13)$$

$$\mathbf{H}_\perp = \frac{i}{Z_0} [\boldsymbol{\rho}^0, \mathbf{E}_\perp], \quad \Phi_m(\varphi, \alpha) = \begin{cases} \cos(m\alpha) \cos(m\varphi), & m - \text{нечетное}; \\ \sin(m\alpha) \sin(m\varphi), & m - \text{четное}. \end{cases}$$

Рассмотрим электромагнитное поле внутри радиального волновода в дальней зоне. Воспользуемся в выражениях (8) и (9) только верхними строчками, а для функции Ханкеля используем ее асимптотическое представление при  $k\rho \rightarrow \infty$ . Тогда выражение (13) принимает вид

$$\mathbf{E}_\perp = -\frac{kZ_0 I_0^3}{2} H_0^{(2)}(k\rho) F(\varphi) \mathbf{z}^0;$$

$$\mathbf{H}_\perp = \frac{i}{2} \frac{kI_0^3}{2} H_0^{(2)'}(k\rho) F(\varphi) \boldsymbol{\varphi}^0,$$

где  $F(\varphi)$  — диаграмма направленности.

Если источник возбуждения расположен так, что  $(k\rho)_{\text{кр}n} < kb < (k\rho)_{\text{кр}n+1}$ , где  $(k\rho)_{\text{кр}n}$  — критическое сечение  $n$ -го типа волны, то выражение для диаграммы направленности имеет следующий вид:

$$F(\varphi) = \frac{1+i}{2} \sum_{m=1}^n J_m(kb) e^{-i\frac{m\pi}{2}} \Phi_m(\varphi, \alpha) + \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{\xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}] - i}{1 + \xi_m^2[(k\rho)_{\text{кр}}]} J_m(kb) e^{i\frac{m\pi}{2}} \Phi_m(\varphi, \alpha). \quad (14)$$

Первая сумма в правой части формулы (14) учитывает вклад в диаграмму направленности тех типов волн, критические сечения которых находятся ниже источника возбуждения (см. рис. 1, б), а вторая сумма — тех типов волн, критические сечения которых находятся выше источника возбуждения.

Пусть источник возбуждения расположен так, что  $\alpha = 0$ . Тогда в соответствии с (13)  $\Phi_m(\varphi, \alpha) = \cos(m\varphi)$ , где  $m$  — нечетные числа, т. е.  $m = 1, 3, 5, \dots$

Значения критических сечений первых четырех нечетных типов волн и соответствующие значения коэффициента  $\xi_m(x)$  приведены ниже:

$m$ .....	1	3	5	7
$(k\rho)_{\text{кр}}^{\langle E_{m0} \rangle}$ .....	0,866	2,958	4,975	6,982
$\xi_m[(k\rho)_{\text{кр}}^m]$ .....	-2,3	-1,8	-1,7	-1,7

Разделяя действительную и мнимую части выражения (14), получаем

$$\operatorname{Re} F(\varphi) = -0,5 \sum_{m=1}^n J_m(kb)(\pm 1) \cos(m\varphi) + \sum_{m=n+1}^{\infty} J_m(kb) \frac{(\pm 1) \cos(m\varphi)}{1 + \xi_m^2 [(k\rho)_{\text{кр}}^m]};$$

$$\operatorname{Im} F(\varphi) = 0,5 \sum_{m=1}^n J_m(kb)(\pm 1) \cos(m\varphi) + \sum_{m=n+1}^{\infty} J_m(kb) \frac{(\pm 1) \xi_m [(k\rho)_{\text{кр}}^n] \cos(m\varphi)}{1 + \xi_m^2 [(k\rho)_{\text{кр}}^m]}.$$

В скобках знак «+» для  $m = 1, 5, 9, \dots$ , а знак «-» для  $m = 3, 7, 11, \dots$

Тогда модуль диаграммы направленности будем вычислять по соотношению

$$|F(\varphi)| = \left\{ [\operatorname{Re} F(\varphi)]^2 + [\operatorname{Im} F(\varphi)]^2 \right\}^{1/2}. \quad (15)$$

Трансформация модуля диаграммы направленности (15) в зависимости от положения источника возбуждения показана на рис. 2.

Когда источник расположен в запредельной области волны « $E_{10}$ »:

$kb = 0,5 < (k\rho)_{\text{кр}}^{\langle E_{10} \rangle} = 0,866$ , то эффективность возбуждения мала

(график — штриховая кривая на рис. 2, а). Если источник размещен выше критического сечения « $E_{10}$ », но не достигает критического сечения для волны « $E_{30}$ »

$(k\rho)_{\text{кр}}^{\langle E_{10} \rangle} = 0,866 < kb = 1,0; 1,5; 2,0 < (k\rho)_{\text{кр}}^{\langle E_{10} \rangle} =$

$= 2,958$ , то эффективность возбуждения резко возрастает, причем вклад в излучаемое поле вносит волна « $E_{10}$ ».

Если источник возбуждения приближается к критическому сечению волны « $E_{30}$ », например, при  $kb = 2,9$ , то как видно из рис. 2, б (штриховая кривая) проявляется влияние возбуждения волны « $E_{30}$ ».

При переходе через критическое сечение волны « $E_{30}$ » основной вклад в излучаемое поле вносит волна « $E_{30}$ » (штрих-пунктирная кривая на рис. 2, б).

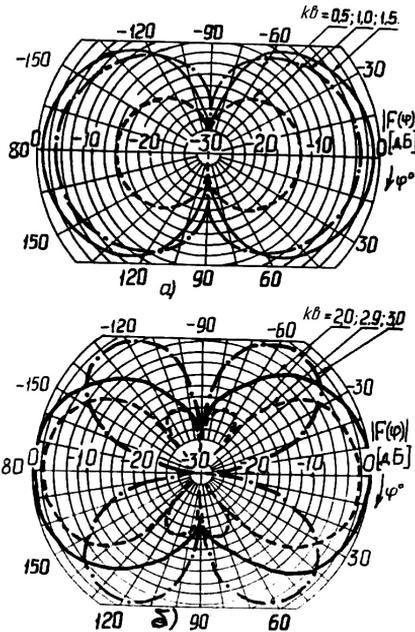
Наибольшая эффективность излучения наблюдается при положении источника  $kb = 2,0$ . Это подтвер-

дится на рис. 2, б (штриховая кривая).

При переходе через критическое сечение волны « $E_{30}$ » основной вклад в излучаемое поле вносит волна « $E_{30}$ » (штрих-пунктирная кривая на рис. 2, б).

Наибольшая эффективность излучения наблюдается при положении источника  $kb = 2,0$ . Это подтвер-

дится на рис. 2, б (штриховая кривая).



**Рис. 2.** Диаграмма направленности радиальной линии передачи в зависимости от положения стороннего источника:

а — для значений  $kb \leq 1,5$ ; б — для значений  $kb \geq 2$

ждает и рис. 3, на котором изображены максимальные значения модуля диаграммы направленности в зависимости от положения источника возбуждения. Эффективное возбуждение радиального волновода соответствует положению источника в окрестности точки  $kb = 2,0$  ( $1,5 < kb < 2,5$ ).

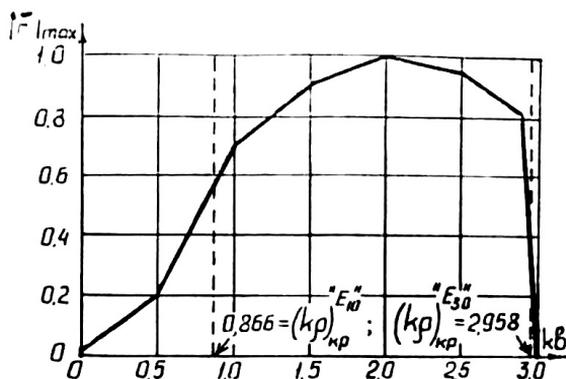


Рис. 3. Определение точки эффективного возбуждения

**Излучение круглой микрополосковой антенны в режиме эффективного возбуждения.** Используя модель объемного резонатора при анализе круглой микрополосковой антенны в работе [2] показано, что микрополосковую антенну можно смоделировать в виде диэлектрически нагруженного объемного радиального резонатора с двумя идеально проводящими электрическими стенками (верхней и нижней) и идеально проводящей магнитной цилиндрической поверхностью. Предполагается, что материал подложки усечен и не простирается дальше кромки полоска (рис. 4). Боковая поверхность представляет собой апертуру (щель) через которую происходит излучение.

Используя теорему эквивалентности, боковую щель можно охарактеризовать эквивалентным магнитным током плотностью

$$\mathbf{j}_s^M = -[\mathbf{n}^0, \mathbf{E}_a],$$

где  $\mathbf{n}^0$  — единичный вектор внешней нормали к апертуре,  $\mathbf{E}_a$  — вектор напряженности электрического поля на щели. Плотности эквивалентных электрических токов, возникающих на верхней и нижней частях полоска, оказываются очень малы-

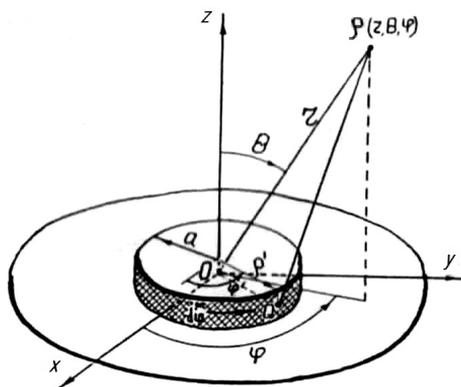


Рис. 4. Структура круглой микрополосковой антенны

ми и ими пренебрегают. Присутствие заземленной плоскости (см. рис. 4) учитывают с помощью теории зеркальных изображений. Тогда результирующий эквивалентный магнитный ток плотностью  $\mathbf{j}_s^M$  будет удваиваться:

$$\mathbf{j}_s^M = -2[\mathbf{n}^0, \mathbf{E}_a]. \quad (16)$$

Апертурную напряженность электрического поля в щели можно определить из выражения (13) с учетом полученных выше результатов:

$$\mathbf{E}_a = \mathbf{E}_\perp \Big|_{\rho=a_{\text{эф}}} = \frac{kE_0}{2} \left\{ \frac{1}{2} (1+i) J_1(2) H_1^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos \varphi' + \right. \\ \left. + \sum_{m=3}^{\infty} \frac{\xi_m [(k\rho)_{\text{кр}}^m] - i}{1 + \xi_m^2 [(k\rho)_{\text{кр}}^m]} J_m(2) H_m^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos(m\varphi') \right\} \mathbf{z}^0,$$

где  $E_0 = Z_0 I_0^0$ ;  $a_{\text{эф}}$  – эффективный радиус полоска, определяемый краевыми эффектами в окрестности кромки круглого полоска [3],

$$a_{\text{эф}} = a \left\{ 1 + \frac{2h}{\pi a \varepsilon} \left[ \ln \left( \frac{\pi a}{2h} \right) + 1,7726 \right] \right\}^{1/2}. \quad (17)$$

Здесь  $a$  — физический радиус полоска;  $h$  — высота подложки;  $\varepsilon$  — относительная диэлектрическая проницаемость подложки.

Воспользовавшись соотношением (16) плотность эквивалентного магнитного тока можно представить в следующем виде:

$$\mathbf{j}_s^M = -2[\mathbf{n}^0, \mathbf{E}_0] = -2[\boldsymbol{\rho}^0, \mathbf{E}_\perp \Big|_{\rho=a_{\text{эф}}}] = kE_0 \left\{ \frac{1}{2} (1+i) J_1(2) H_1^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos \varphi' + \right. \\ \left. + \sum_{m=3}^{\infty} \frac{\xi_m [(k\rho)_{\text{кр}}^m] - i}{1 + \xi_m^2 [(k\rho)_{\text{кр}}^m]} J_m(2) H_m^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos(m\varphi') \right\} \boldsymbol{\rho}^0. \quad (18)$$

Поскольку высота подложки очень мала и плотность тока (18) равномерна вдоль направления  $\mathbf{z}^0$  можно ввести нитевидный магнитный ток  $\mathbf{I}_M = h \mathbf{j}_s^M$ ,

$$\mathbf{I}_M = V_0 \frac{k}{h} \left\{ \frac{1}{2} (1+i) J_1(2) H_1^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos \varphi' + \right. \\ \left. + \sum_{m=3}^{\infty} \frac{\xi_m [(k\rho)_{\text{кр}}^m] - i}{1 + \xi_m^2 [(k\rho)_{\text{кр}}^m]} J_m(2) H_m^{(2)}(ka_{\text{эф}}) \cos(m\varphi') \right\} \boldsymbol{\rho}^0, \quad (19)$$

где  $V_0 = hE_0$  — разность потенциалов в устройстве возбуждения. Рассматриваемая микрополосковая антенна может быть представлена [2] в виде круговой рамки с магнитным током  $\mathbf{I}_M = \Phi^0 I_\varphi^M$ , излучающая в свободное пространство (см. рис. 4). Она размещается симметрично на плоскости  $xOy$  при  $z = 0$ . Поле излучения определяется с помощью векторного потенциала

$$\mathbf{A}^M(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \int_C \mathbf{I}_M(x', y', z') \frac{e^{-ikR}}{R} dl'. \quad (20)$$

Здесь координаты с индексом «'» относятся к точкам источника  $Q(x', y', z')$ , а координаты без «'» — к точке наблюдения  $P(x, y, z)$ ;  $R$  — расстояние от какой-либо точки на рамке до точки наблюдения;  $dl'$  — бесконечно малый участок рамочной системы.

Пространственное распределение тока  $\mathbf{I}_M(x', y', z')$  можно записать в виде

$$\mathbf{I}_M(x', y', z') = \mathbf{x}^0 I_x(x', y', z') + \mathbf{y}^0 I_y(x', y', z') + \mathbf{z}^0 I_z(x', y', z'). \quad (21)$$

Компоненты тока вдоль кругового отрезка удобно представить в цилиндрических координатах  $(\rho, \varphi, z)$ , используя преобразование

$$\begin{pmatrix} I_x \\ I_y \\ I_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi' & -\sin \varphi' & 0 \\ \sin \varphi' & \cos \varphi' & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_\rho \\ I_\varphi \\ I_z \end{pmatrix}, \quad (22)$$

раскрывая которое получим

$$\left. \begin{aligned} I_x &= I_\rho \cos \varphi' - I_\varphi \sin \varphi' \\ I_y &= I_\rho \sin \varphi' + I_\varphi \cos \varphi' \\ I_z &= I_z \end{aligned} \right\}. \quad (23)$$

Поскольку излучение поля обычно определяется в сферических координатах, то прямоугольные единичные векторы преобразуются в сферические единичные векторы, используя матрицу преобразования от декартовых координат к сферическим в форме

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^0 &= \mathbf{r}^0 \sin \theta \cos \varphi + \boldsymbol{\theta}^0 \cos \theta \cos \varphi - \boldsymbol{\phi}^0 \sin \varphi; \\ \mathbf{y}^0 &= \mathbf{r}^0 \sin \theta \sin \varphi + \boldsymbol{\theta}^0 \cos \theta \sin \varphi + \boldsymbol{\phi}^0 \cos \varphi; \\ \mathbf{z}^0 &= \mathbf{r}^0 \cos \theta - \boldsymbol{\theta}^0 \sin \theta. \end{aligned} \quad (24)$$

Подставляя (23) и (24) в (21), получаем выражение

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_M = & \mathbf{r}^0 [I_\rho \sin \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') + I_z \cos \theta] + \\ & + \theta^0 [I_\rho \cos \theta \cos(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') - I_z \sin \theta] + \\ & + \varphi^0 [-I_\rho \sin(\varphi - \varphi') + I_\varphi \cos(\varphi - \varphi')]. \end{aligned} \quad (25)$$

Для круглой рамки магнитный ток, протекающий в направлении  $\varphi^0$  ( $I_\varphi^M$ ), по формуле (25) преобразуется к виду

$$\mathbf{I}_M = \mathbf{r}^0 I_\varphi \sin \theta \sin(\varphi - \varphi') + \theta^0 I_\varphi \cos \theta \sin(\varphi - \varphi') + \varphi^0 I_\varphi \cos(\varphi - \varphi'). \quad (26)$$

Расстояние

$$R = [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2}$$

можно преобразовать с учетом того, что  $x = r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ ,  $x' = a_{\text{эф}} \cos \varphi'$ ,  $y' = a_{\text{эф}} \sin \varphi'$ ,  $z' = 0$ ,  $x'^2 + y'^2 + z'^2 = a_{\text{эф}}^2$ , тогда

$$R = \sqrt{r^2 + a_{\text{эф}}^2 - 2a_{\text{эф}} r \sin \theta \cos(\varphi - \varphi')}. \quad (27)$$

На рис. 4 дифференциальный элемент длины рамки имеет вид

$$dl' = a_{\text{эф}} d\varphi'. \quad (28)$$

Используя выражения (26), (27) и (28)  $\varphi$ -ю компоненту векторного магнитного потенциала из (20) можно записать в виде

$$A_\varphi^M = \frac{a_{\text{эф}}}{4\pi} \int_0^{2\pi} I_\varphi \cos(\varphi - \varphi') \frac{e^{-ikR}}{R} d\varphi', \quad (29)$$

где вместо  $R$  подставляется выражение (27). Соответственно компоненты  $A_r^M$  и  $A_\theta^M$  из (20) представляются в следующем виде:

$$A_r^M = \frac{a_{\text{эф}} \sin \theta}{4\pi} \int_0^{2\pi} I_\varphi \sin(\varphi - \varphi') \frac{e^{-ikR}}{R} d\varphi'; \quad (30)$$

$$A_\theta^M = \frac{a_{\text{эф}} \cos \theta}{4\pi} \int_0^{2\pi} I_\varphi \sin(\varphi - \varphi') \frac{e^{-ikR}}{R} d\varphi'. \quad (31)$$

Выражения для векторов напряженностей электрического и магнитного полей круглой рамки можно получить из векторного магнитного потенциала по формулам:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(r, \theta, \varphi) &= -\operatorname{rot} \mathbf{A}^M(r, \theta, \varphi); \\ \mathbf{H}(r, \theta, \varphi) &= -\frac{1}{i\omega\mu_a} \left[ \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{A}^M(r, \theta, \varphi) + k^2 \mathbf{A}^M(r, \theta, \varphi) \right]. \end{aligned} \quad (32)$$

Методика вычисления интегралов (29)—(31), как и вычислений полей (32) при различных амплитудно-фазовых распределениях тока  $I_\varphi$  различных антенн приведена в работе [10].

Таким образом, использование модели радиальной линии передачи круглой микрополосковой антенны позволяет определить область возможного положения зонда для ее эффективного возбуждения при малой высоте подложки.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Устройства СВЧ и антенны. Проектирование фазированных антенных решеток / Под ред. Д.И. Воскресенского – М.: Радиотехника, 2012. – 744 с.
2. Balanis A. Antenna Theory: Analysis Design, Third Edition: John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 1117 p.
3. Лось В. Ф. Микрополосковые и диэлектрические резонаторные антенны. САПР-модели: методы математического моделирования / Под ред. Л.Д. Бахраха. – М.: ИПРЖР, 2002. – 96 с.
4. Электродинамический расчет характеристик излучения полосковых антенн / С.Т. Князев, Б.А. Панченко, Ю.Б. Нечаев и др. – М.: Радио и связь, 2002. – 256 с.
5. Панченко Б. А., Нефедов Е. И. Микрополосковые антенны. – М.: Радио и связь, 1986. – 144 с.
6. Ванштейн А. А. Электромагнитные волны. – М.: Радио и связь, 1988. – 440 с.
7. Голубева Н. С., Митрохин В. Н. Основы радиоэлектроники сверхвысоких частот. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 488 с.
8. Митрохин В. Н. Электродинамические характеристики цилиндрических направляемых волн в слоистых СВЧ-структурах // Радиотехника. – 2002. – № 8. – С. 64–72.
9. Митрохин В. Н. Исследование переходных полей в неоднородных СВЧ-структурах с критическими сечениями // Радиотехника. – 1999. – № 4. – С. 86–91.
10. Werner D. H. An Exact Integration Procedure for Vector Potentials of Thin Circular Loop Antennas // IEEE Trans. Antennas Propagat. – 1996. – Vol. 44. – No. 2. – P. 157–165.

Статья поступила в редакцию 07.09.2012